

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы интегральные 198НТ2АТВК, 198НТ2БТВК, 198НТ2АТ1ВК, 198НТ2БТ1ВК соответствуют техническим условиям АЕЯР.431410.245 ТУ; ОСМ198НТ2АТ1ВК, ОСМ198НТ2БТ1ВК соответствуют техническим условиям АЕЯР.431410.245 ТУ и ПО.070.052 и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № _____ от _____
Дата

Штамп ОТК _____ Штамп представителя заказчика _____

Перепроверка произведена _____
Дата

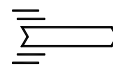
Приняты по извещению № _____ от _____
Дата

Штамп ОТК _____ Штамп представителя заказчика _____

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«ВНИМАНИЕ-Соблюдайте меры предосторожности при работе – ПРИБОРЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ».

Допустимое значение статического потенциала 200 В.



МИКРОСХЕМЫ 198НТ2АТВК, 198НТ2БТВК, 198НТ2АТ1ВК, 198НТ2БТ1ВК, ОСМ198НТ2АТ1ВК, ОСМ198НТ2БТ1ВК

Код ОКП :

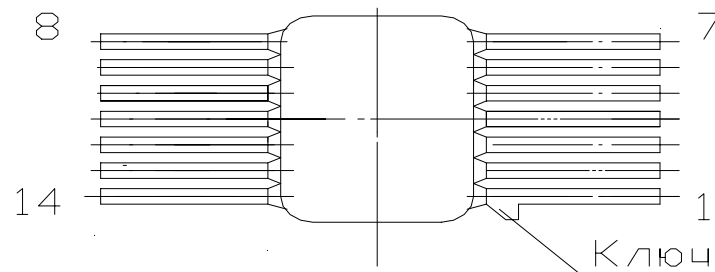
6331328255 – 198НТ2АТВК	6331328295 – 198НТ2БТВК
6331328265 - 198НТ2АТ1ВК, ОСМ198НТ2АТ1ВК	6331328305 – 198НТ2БТ1ВК, ОСМ198НТ2БТ1ВК

ЭТИКЕТКА

САЛ.431130.030 ЭТ2

Микросхемы интегральные 198НТ2АТВК, 198НТ2БТВК, 198НТ2АТ1ВК, 198НТ2БТ1ВК, ОСМ198НТ2АТ1ВК, ОСМ198НТ2БТ1ВК – матрица транзисторов NPN типа.

Схема расположения выводов

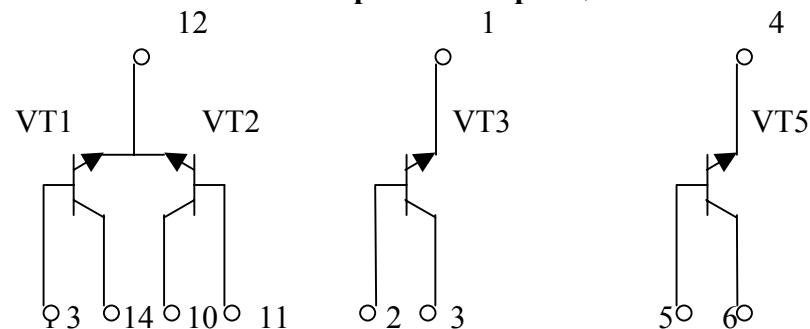


Нумерация выводов показана условно.

Ключ показывает начало отсчета выводов.

Масса не более 0,8 г.

Схема электрическая принципиальная



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
при температуре (25±5) °С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Бук- вен- ное обоз- наче- ние	Норма			
		198НТ2АТ1ВК 198НТ2АТ1ВК ОСМ198НТ2АТ1ВК		198НТ2БТ1ВК 198НТ2БТ1ВК ОСМ198НТ2БТ1ВК	
		не менее	не более	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока при: $U_{CB} = -3$ В; $I_E = -0,5$ мА	h_{21E}	30	200	30	200
Обратный ток эмиттера, нА	I_{EBO}	-	100	-	100
Обратный ток коллектора, мкА, при: $U_{CB} = 6$ В	I_{CBO}	-	0,05	-	0,05
Напряжение насыщения база-эмиттер, В, при: $I_C = 3$ мА; $I_B = 0,5$ мА	U_{BEsat}	-	0,8	-	0,8
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, при: $I_C = 3$ мА; $I_B = 0,5$ мА	U_{CEsat}	-	0,2	-	0,2
Разброс статических коэффициентов передачи тока (транзисторов VT1 VT2) ,%, при: $U_{CB} = 3$ В; $I_B = -0,5$ мА	Δh_{21E}	-	15	-	15
Разброс напряжения база-эмиттер (транзисторов VT1 VT2), мВ, при: $U_{CB} = 3$ В; $\Sigma I_E = 0,5$ мА	ΔU_{BE}	-	3	-	10
Ток утечки, нА	I_L	-	50	-	50

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:
- золото

Цветных металлов не содержится.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка (Тнм) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в следующих облегченных режимах при напряжениях, токах и мощностях, не превышающих 60 % от предельных значений – 120000 ч.

Гамма-процентный ресурс (Т_γ) микросхем при $\gamma = 95\%$ 200000 ч

Минимальный срок сохраняемости микросхем (Тсм) при их хранении:

- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет;
- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
- под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.

Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431410.245 ТУ, а микросхем с индексом «ОСМ» - АЕЯР.431410.245 ТУ и ПО.070.052 в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.